

1直リチウムイオン/リチウムポリマー二次電池用保護IC

MD1421ExxCPAL シリーズ

概要

MD1421ExxCPALシリーズは保護ICとMOS-FETを1つのパッケージに内蔵したリチウムイオン/リチウムポリマー二次電池の保護用ICです。リチウムイオン/リチウムポリマー電池1セルの過充電、過放電、放電過電流、短絡、充電過電流及び過大充電器の検出が可能です。

特長

(特記なき場合、Ta=25°C)

1) 各種検出/復帰電圧の選択範囲と精度

・ 過充電検出電圧	4.1V~4.45V, 5mVステップで選択可能	精度±20mV
・ 過充電復帰電圧	3.9V~4.3V ※1	精度±50mV
・ 過放電検出電圧	2.0V~3.0V ※2	精度±100mV
・ 過放電復帰電圧	2.0V~3.2V ※2	精度±100mV
・ 放電過電流検出電圧	+40mV~+180mV, 5mVステップで選択可能	精度±5mV
・ 充電過電流検出電圧	-180mV~-40mV, 5mVステップで選択可能	精度±15mV
・ 短絡検出電圧	0.56V, 0.9Vから選択可能	精度±100mV
・ 過大充電器検出電圧	VCC-8.0V 固定	精度±2.0V
・ 過大充電器復帰電圧	VCC-7.3V 固定	精度±1.5V

※1 過充電検出/復帰電圧のヒステリシス電圧は、0.10V/0.15V/0.20V/0.25Vから選択可能です。

※2 過放電検出/復帰電圧の設定の詳細に関しては弊社までお問い合わせください。

2) 各種検出遅延時間の選択範囲

・ 過充電検出遅延時間	1.0s, 4.5s, 6.25sから選択可能
・ 過放電検出遅延時間	100ms, 256ms から選択可能
・ 放電過電流検出遅延時間	8ms, 12ms, 16ms, 20ms, 34ms から選択可能
・ 充電過電流検出遅延時間	8.5ms, 25ms, 32.5ms から選択可能
・ 短絡検出遅延時間	0.50ms, 0.75ms, 1.00msから選択可能

3) 0V電池への充電機能 「禁止」/「許可」の選択が可能

4) 過充電検出遅延タイマリセット機能（パルス充電対応機能）有り

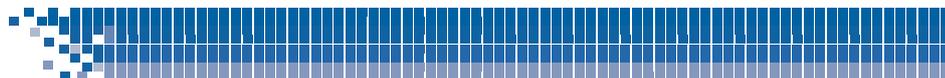
5) 低消費電流

・ 通常動作モード時	Typ. 3.0uA, Max. 5.2uA
・ スタンバイモード時	Max. 0.1uA（過放電復帰条件が「充電器接続復帰」の場合） Max. 0.5uA（過放電復帰条件が「電圧復帰」の場合）

6) MOS-FET

・ ソース・ソース間オン抵抗	Typ. 38.0mΩ (@VCC=3.7V)
----------------	-------------------------





7) パッケージ

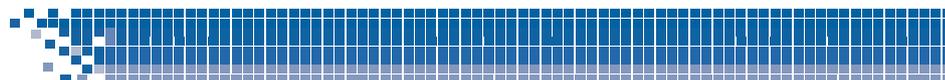
・ PLP-4-1228

2.85 × 1.25 × 0.60 [mm]

端子説明

PLP-4-1228	端子番号	名称	機能
	1	S1	負側電源入力および放電MOS-FETソース端子。 電池のマイナス側に接続します。
	2	VCC	正側電源入力端子。 R1を介して電池のプラス側に接続します。
	3	IDT	充電器マイナス電位入力端子。 R2を介してS2端子に接続します。
	4	S2	充電側MOS-FETのソース端子。 充電器のマイナス側に接続します。
	-	D	充電および放電MOS-FETのドレイン端子。 電氣的に開放にしてください。





絶対最大定格

項目	記号	最小	最大	単位
電源電圧	VCC	-0.3	12	V
端子電圧	VIDT	VCC-24	VCC+0.3	V
ドレイン・ソース間電圧	VDSS	-	24	V
ドレイン電流	ID	-	6.0	A
保存温度	TSTG	-40	125	°C

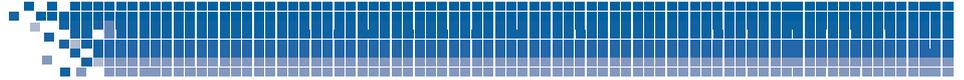
推奨動作範囲

項目	記号	最小	最大	単位
動作周囲温度	TOPE	-40	85	°C
動作電圧	VCCop1	1.5	5.5	V

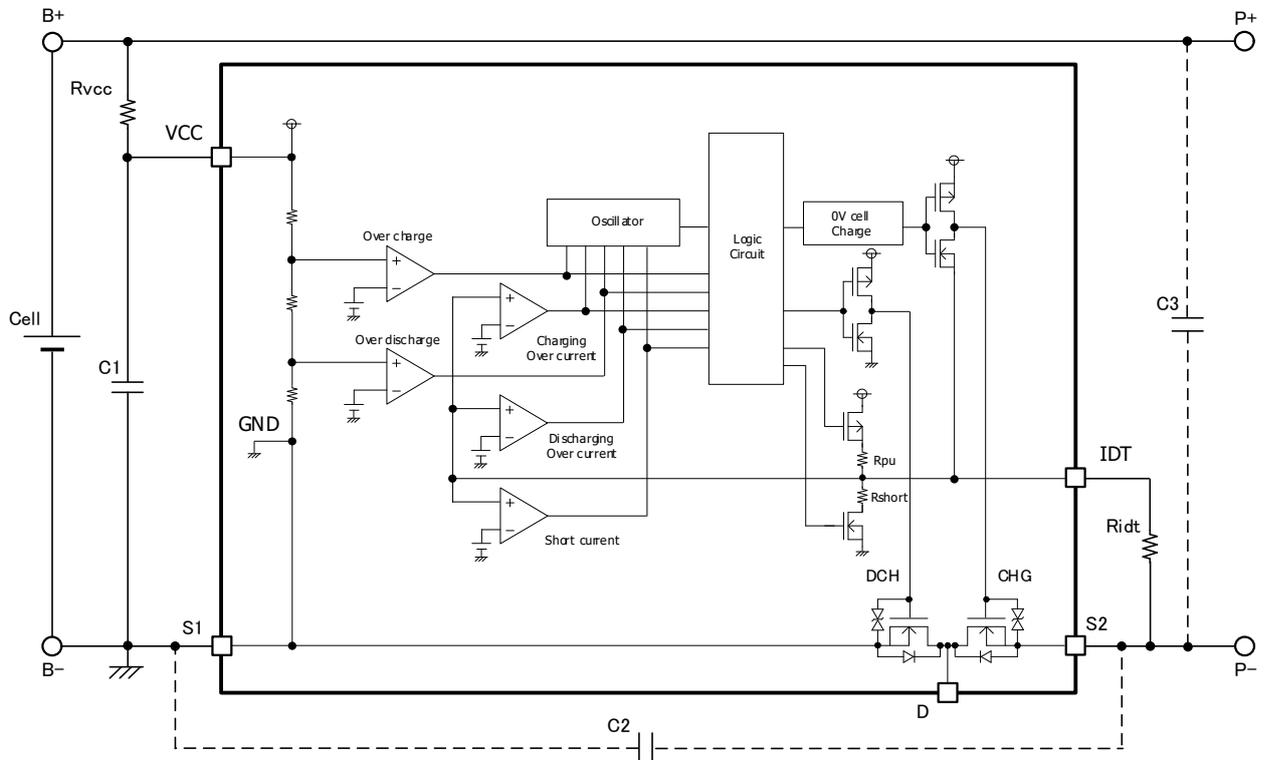
電気的特性

(特記なき場合、Ta=25°C)

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
消費電流項目						
通常動作時消費電流	Icc1	VCC=3.6V, IDT=0V	-	3.0	5.2	uA
スタンバイ時消費電流	Icc2	Vdet2 = Vrel2	-	-	0.1	uA
	Icc3	Vdet2 ≠ Vrel2	-	-	0.5	uA
検出/復帰電圧項目						
過充電検出電圧	V1		Typ-0.020	V1	Typ+0.020	V
過充電復帰電圧	V2		Typ-0.050	V2	Typ+0.050	V
過放電復帰電圧	V3		Typ-0.100	V3	Typ+0.100	V
過放電検出電圧	V4		Typ-0.100	V4	Typ+0.100	V
放電過電流検出電1	V5_1	VCC=4.5V	Typ-0.008	V5_1	Typ+0.008	V
放電過電流検出電2	V5_2	VCC=3.5V	Typ-0.005	V5_2	Typ+0.005	V
放電過電流検出電3	V5_3	VCC=2.5V	Typ-0.008	V5_3	Typ+0.008	V
短絡検出電圧	V6		Typ-0.100	V6	Typ+0.100	V
0V充電禁止最大電圧	V7		0.40	0.65	1.10	V
			0.65	0.90	1.25	V
過大充電器検出電圧	V8det		6.0	8.0	10.0	V
過大充電器復帰電圧	V8rec		5.8	7.3	8.8	V
充電過電流検出電圧	V9		Typ-0.015	V9	Typ+0.015	V
検出遅延時間項目						
過放電検出遅延時間	Tsp1		Typ*0.75	Tsp1	Typ*1.25	ms
放電過電流検出遅延時間	Tsp2		Typ*0.75	Tsp2	Typ*1.25	ms
過充電検出遅延時間	Tsp3		Typ*0.75	Tsp3	Typ*1.25	s
短絡検出遅延時間	Tsp4		Typ*0.75	Tsp4	Typ*1.25	us
充電過電流検出遅延時間	Tsp5		Typ*0.75	Tsp5	Typ*1.25	ms
MOS-FET項目						
ドレイン遮断電流	IDSS	VDS=24V	-	-	1.0	uA
ソース・ソース間オン抵抗1	RSS(on)1	VCC=4.5V, Is=1.0A	27.0	36.0	45.0	mΩ
ソース・ソース間オン抵抗2	RSS(on)2	VCC=3.5V, Is=1.0A	30.0	39.0	48.0	mΩ
ソース・ソース間オン抵抗3	RSS(on)3	VCC=2.5V, Is=1.0A	33.0	48.0	65.0	mΩ
ボディダイオード順電圧	VSD	Is=1A	0.50	0.70	1.00	V



ブロック図/応用回路例



記号	部品	最小値	推奨値	最大値	単位
Rvcc	Resistor	-	33	470	Ω
C1/C2/C3	Capacitor	0.01	0.1	1.0	uF
Ridt	Resistor	-	2.7k	-	Ω

※使用上の注意点

各端子に挿入された抵抗はICの保護用のものです。静電破壊耐圧、ラッチアップ耐圧の向上に効果があります。コンデンサは電圧の変動や外来電磁ノイズに対する耐力および静電破壊耐圧の向上に効果があります。C2、C3は両方もしくはいずれかのご使用をご検討下さい。

上記回路は参考例です。抵抗や容量の挿入の要否、挿入位置および定数はシステムとしての機能や特性をご確認の上選定してください。